

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОТНОСТЬ ПРЕДЕЛЬНО СЛОИСТЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ *p*- И *n*-ТИПОВ

В.В.Бабенко, В.Г.Бутько, В.А.Волошин, И.М.Резник, Е.В.Фоскарино

Донецкий физико-технический институт АН Украины

340114 Донецк, Украина

Поступила в редакцию 2 марта 1995 г.

Проведен расчет и построены карты распределения электронной плотности предельно слоистых сверхпроводников *p*- и *n*-типов. Показано, что максимальные различия этих двух типов регистрируются в плоскости (0;0;0,5). Высказано предположение, что замена трехвалентного редкоземельного иона на четырехвалентный (например, Pr^{4+} или Tb^{4+}) может повысить значение T_c .

Известно, что имеется некоторая корреляция между числом близко расположенных меднокислородных плоскостей и температурой перехода в сверхпроводящее состояние T_c . Поэтому понятны надежды (частично уже оправдавшиеся), связанные с синтезом предельно слоистых сверхпроводников (*the infinite layer superconductors*). Эти сверхпроводники могут быть двух типов – с дырочной и электронной проводимостью. Примером первого типа является сверхпроводник $\text{Sr}_{0,7}\text{Ca}_{0,3}\text{CuO}_2$ с $T_c = 110\text{ K}$ [1]. Примером второго, по утверждению авторов [2], является $\text{Sr}_{1-x}\text{Nd}_x\text{CuO}_2$ с рекордной для сверхпроводников *n*-типов $T_c = 44\text{ K}$. Причем температура перехода в сверхпроводящее состояние не зависит от концентрации Nd (от $x = 0,05$ до $x = 0,10$).

В работе [3] рассматривались данные по электронной плотности (ЭП) $\text{Sr}_{1-x}\text{Ca}_x\text{CuO}_2$, причем расчет велся для отдельных тетрагональных ячеек CaCuO_2 ($a = 3,86\text{ \AA}$ и $c = 3,20\text{ \AA}$) и SrCuO_2 ($a = 3,926\text{ \AA}$ и $c = 3,432\text{ \AA}$). В частности, приводится карта для плоскости (001), из которой можно заключить о сильном Cu–O–взаимодействии, карта для плоскости (010), свидетельствующая о двумерном характере распределения ЭП в *c*-направлении, и карта диагональной плоскости (110), показывающая очень низкую ЭП вокруг узла Ca.

Самосогласованное распределение ЭП нами получено в результате неэмпирических расчетов модифицированным методом Томаса–Ферми [4]. Ранее этим методом исследовались высокотемпературные сверхпроводники $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ [5] и La_2CuO_4 [6].

В настоящей работе расчет распределения ЭП проводится для "четырех" ячеек, как для дырочного сверхпроводника, так и для электронного, то есть для $\text{Sr}_3\text{Ca}(\text{CuO}_2)_4$ ($a = 7,814\text{ \AA}$, $c = 3,363\text{ \AA}$, число электронов $n = 64$) и для $\text{Sr}_3\text{Nd}(\text{CuO}_2)_4$ ($a = 7,90\text{ \AA}$, $c = 3,39\text{ \AA}$, $n = 65$). Структура и ее параметры приводятся на рис.1. Реальный состав сверхпроводника *n*-типа приблизительно $\text{Sr}_9\text{Nd}(\text{CuO}_2)_{10}$. Из-за сложности расчета принималась ячейка $\text{Sr}_3\text{Nd}(\text{CuO}_2)_4$, в которой концентрация неодима выше. Однако принимается, что распределение ЭП вблизи Nd и его ближайших соседей значительно не изменится. Поэтому на картах распределения ЭП приводятся "тройные" ячейки.

Карты распределения ЭП в плоскостях (001) и (010) как для соединения $\text{Sr}_3\text{Ca}(\text{CuO}_2)_4$, так и для соединения $\text{Sr}_3\text{Nd}(\text{CuO}_2)_4$ очень близки к данным

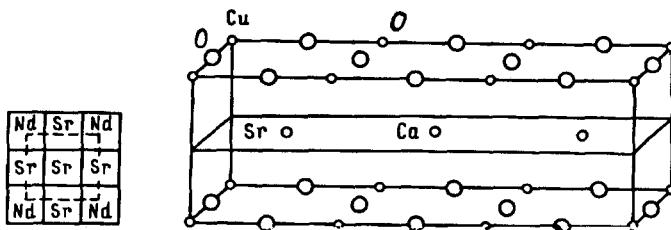


Рис.1. а – Одна из моделей кристалла $Sr_3Nd(CuO_2)_4$. Выделена рассчитываемая ячейка.
б – Строение ячейки $Sr_2Ca(CuO_2)_3$

для этих плоскостей, приведенных в работе [3], и поэтому в настоящем сообщении не приводятся. Влияние иона неодима, находящегося на расстоянии $\sim 1,5 \text{ \AA}$ от этих плоскостей, весьма незначительное (некоторое уменьшение ЭП в центре карты). Наиболее незначительное (некоторое уменьшение ЭП в центре карты). Наиболее резко различие между двумя видами сверхпроводников видно на рис.2, верх которого представляет собой карту плоскости $(0;0;0,5)$, расположенной между базовыми плоскостями сверхпроводника *p*-типа, а низ – ту же плоскость сверхпроводника *n*-типа. Середину рисунка занимает сравнение кривых изменения ЭП по продольным осям карт. Видно, что ЭП сверхпроводника *p*-типа изменяется регулярно от нуля в области кора ионов Sr и Ca и до $\sim 14e/\text{ячейку}$ в промежуточной области.

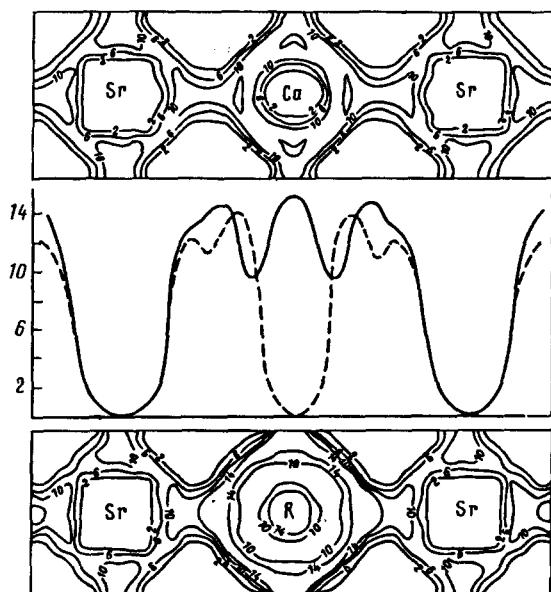


Рис.2. Сравнение ЭП в плоскости $(0;0;0,5)$ $Sr_3Ca(CuO_2)_4$ (верх) и $Sr_3Nd(CuO_2)_4$ (низ), в середине сравнение кривых изменения ЭП по продольным осям карт: сплошная линия для $Sr_3Ca(CuO_2)_4$, штриховая – для $Sr_3Nd(CuO_2)_4$. ЭП выражена в числе электронов на ячейку

В сверхпроводниках *n*-типа эта регулярность нарушается в области центрального иона, где ЭП становится максимальной. Разумеется, ясно, что эта

максимальная ЭП обязана трехвалентности редкоземельного атома. Если характер сверхпроводимости n -типа с его рекордной T_c определяется повышенной ЭП вблизи центрального редкоземельного атома, то можно предположить, что увеличение этой плотности еще повысит температуру перехода в сверхпроводящее состояние.

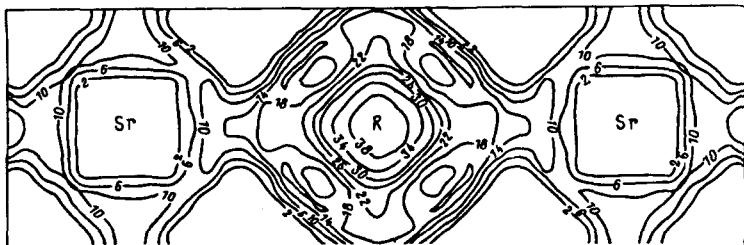


Рис.3. Карта ЭП (0;0;0,5) для $\text{Sr}_3\text{RE}^{4+}(\text{CuO}_2)_4$

На рис.3 показана карта распределения ЭП плоскости (0;0;0,5) в том случае, если в центре ячейки будет находиться четырехвалентный редкоземельный атом. Наиболее вероятная возможность синтеза такого сверхпроводника представляется в случае замены Nd^{3+} празеодимом или тербием.

Работа выполнена в рамках темы ГКНТ Украины "NUT" (09.01.01/034-94) при поддержке Международного научного фонда (грант UI G000).

-
1. M.Azuma, Z.Hiroi, M.Takano et al., *Nature* **358**, 775 (1992).
 2. N.Ikeda, Z.Hiroi, M.Azuma et al., *Phys. C* **210**, 367 (1993).
 3. D.I.Novikov, V.A.Gubanov and A.J.Freeman, *Phys. C* **210**, 301 (1993).
 4. И.М.Резник, *ФТТ* **30**, 3496 (1988).
 5. В.В.Бабенко, В.Г.Бутыко, И.М.Резник, *СФХТ* **2**, 3, 14 (1989).
 6. В.В.Бабенко, В.Г.Бутыко, А.А.Буш и др., *ФТТ* **36**, 241 (1994).